

[訂正と補遺]

GaN系半導体レーザーの可能性：訂正と追記

赤崎 勇・天野 浩

名城大学理工学部電気電子工学科 〒468 名古屋市天白区塩釜口 1-501

「光学」第22卷第11号(1993年11月)670~675ページに掲載の解説「GaN系半導体レーザーの可能性」につき、下記2件の文献の訂正・追記を致します。

(1) p. 675 文献14)を下記のように訂正。

14) 小林敬幸, 菊地 哲, 大木芳正, 赤崎 勇:
特開昭 53-104598; 赤崎 勇, 林 嶽雄: 工業技術, 17, No. 2 (1976) 48; S. Yoshida, S. Misawa and S. Gonda: J. Appl. Phys., 42, No. 5 (1983) 427.

(ぼう線部分は訂正、なみ線部分は追記)

理由: 筆者らは日頃から、「オリジナリティーを尊重すべし」という立場に立ちながら、今回、注意深さを欠いたために生じたミスを修正するためのものであります。このことについて説明します。

本稿(特に「2. 試料作製」以降)では、主として GaN を扱っています。GaN 薄膜は 1960 年代後半から種々の方法で作製されてきましたが、MBE 法で、はじめて GaN を作製したのは小林ら、と Yoshida らのグループです。前者は GaN を主に、後者ははじめ AlN を(のちに GaN も)中心に研究を進めました。本稿では GaN に関して初期の前者関係のみ引用しましたが、後者は重要な成果を挙げており、前者のみ取り上げるのは片

手落ちであると考え、上記の追記をする次第です。

- (2) 図1と同様の図は、既に 1989 年、T. Matsuoka, H. Tanaka, T. Sasaki and A. Katsui: Inst. Phys. Conf. Ser., No. 106 (1989) p. 141 に報告されている。
(なみ線部分を追記)

理由: 1980 年代前半までは、AlGaN 混晶の重要性は、現在ほど広く認識されてはおりませんでした。筆者らは、その重要性を感じ図1に類似のを作りましたが、実際に上記混晶の重要性を指摘し、基本的に図1と同じコンセプトの図を論文として発表したのは、T. Matsuoka ら(1989)です。したがってオリジナリティーの尊重という点から、むしろ上記 Matsuoka らの図を引用すべきでした。しかしながら、図の変更は現段階ではきわめて困難な状況にあると思われますので、現実的な手段として、上記のような追記という形をとりました。

以上のように、二つの追記は何れも学術論文のオリジナリティーを尊重するという立場からの筆者らの自主的な申し出であります。この小文を掲載する機会を与えてくださった「光学」編集委員会に感謝いたします。

(1994年2月21日受理)